



	English	中文	交通アクセス・地図	お問い合わせ	サイトマップ	サイト内検索
	受験生の方	広大へ留学希望の方	一般・地域の方	企業の方	卒業生の方	在学生・保護者の方

大学案内

入試情報

教育・学生生活

研究

社会連携

留学・国際交流

学部・大学院等

研究所・施設等

広報・報道

採用情報

校友会・同窓会

支援財団・基金

図書館・博物館等

大学病院

附属学校

[トップページ](#) > [広報・報道](#) > [報道発表・報道された広島大学](#) > [平成17年1月-12月](#) > 高濃度ホウ素ドーパダイヤモンド超伝導体の電子構造を世界で初めて解明

高濃度ホウ素ドーパダイヤモンド超伝導体の電子構造を世界で初めて解明

報道機関各位

平成17年11月28日

国立大学法人 広島大学

情報化推進部広報課長

5機関共同記者発表

高濃度ホウ素ドーパダイヤモンド超伝導体の電子構造を世界で初めて解明

岡山大学自然科学研究科の横谷尚睦教授らは、(財)高輝度光科学研究センターの中村哲也、松下智裕、室隆桂之各研究員、物質・材料研究機構の長尾雅則研究員、高野義彦主幹研究員、早稲田大学理工学部の竹之内智大氏、川原田洋教授、広島大学の小口多美夫教授らと共同で、低温で超伝導を示す高濃度ホウ素(ボロン)ドーパダイヤモンドの電気伝導を担う電子構造を解明することに世界で初めて成功しました。

詳細は、別紙をご覧くださいませますようお願いいたします。

なお、本件については、本日15時30分から文部科学記者会見で記者発表を行います。

また、本件の報道解禁は、平成17年12月1日(木)午前3時以降となっておりますので、ご協力方よろしくおねがいたします。

広大公式アカウント一覧



【お問い合わせ先】
別紙のとおり

○[別紙:内容詳細](#)